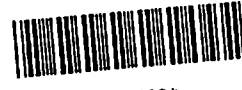


(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



G00002



(43) 国際公開日
2003 年 3 月 20 日 (20.03.2003)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/023797 A1

(51) 国際特許分類: H01G 9/04, 9/012, 9/00

(21) 国際出願番号: PCT/JP02/08793

(22) 国際出願日: 2002 年 8 月 30 日 (30.08.2002)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2001-273126 2001 年 9 月 10 日 (10.09.2001) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電
器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-
TRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒571-8501 大阪府 門真市
大字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 藤井 達雄
(FUJII, Tatsuo) [JP/JP]; 〒552-0001 大阪府 大阪市
港区 波除 4-7-2-1 1 1 0 Osaka (JP). 中野 慎
(NAKANO, Makoto) [JP/JP]; 〒572-0055 大阪府 寝屋

川市御幸東町 3-1 4-3 0 7 Osaka (JP). 御堂 勇
治 (MIDO, Yuji) [JP/JP]; 〒577-0818 大阪府 東大阪市
小若江 2-9-4 6 Osaka (JP). 三木 勝政 (MIKI, Kat-
sumasa) [JP/JP]; 〒573-1145 大阪府 枚方市 黄金野
2-2 3-1 2 Osaka (JP). 木村 涼 (KIMURA, Suzushi)
[JP/JP]; 〒561-0802 大阪府 豊中市曾根東町 2-5-3
Osaka (JP).

(74) 代理人: 岩橋 文雄, 外 (IWAHASHI, Fumio et al.); 〒
571-8501 大阪府 門真市 大字門真 1 0 0 6 番地 松下
電器産業株式会社内 Osaka (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, SG, US.

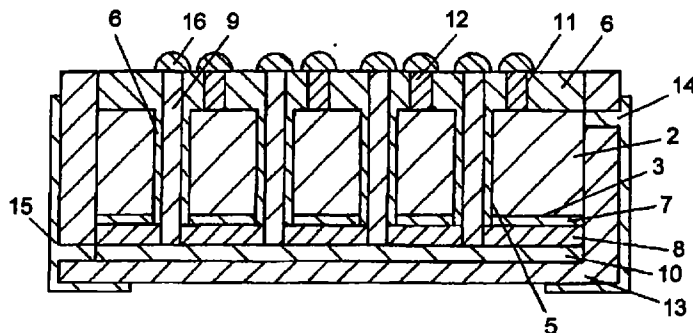
(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY,
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL,
PT, SE, SK, TR).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: METHOD FOR MANUFACTURING SOLID-STATE ELECTROLYTIC CAPACITOR

(54) 発明の名称: 固体電解コンデンサの製造方法



(57) Abstract: A method for manufacturing a
high-capacity solid-state electrolytic capacitor
directly connectable to a semiconductor component
and excellent in high-frequency characteristics
comprises the dielectric forming stage of making a
valve metal sheet (2) porous to form a dielectric film
(7) over a porous surface (3), the element forming
stage of forming a solid-state electrolytic layer (8)
and collector layer (10) over the dielectric film, and
the terminal forming stage of forming a connection
terminal (16) to an external electrode. The element
forming step comprises the electrolyte layer forming
step of forming a solid-state electrolyte layer
(8) over the dielectric film (7), the through-hole
electrode forming step of forming a through-hole electrode (9) in a through hole (5) formed in the valve metal sheet (2), and the collector layer forming step of forming a collector layer (10) over the solid-state electrolyte layer (8).

[続葉有]

WO 03/023797 A1

162162